



| | |
|---|--|
|  | <h2>SI7212DN-T1-E3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI7212DN-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7212DN-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3992 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI7212DN-T1-E3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 3992 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.6V @ 250µA |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 Dual |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 36 mOhm @ 6.8A, 10V |
| Leistung - max | 1.3W |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 Dual |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 11nC @ 4.5V |
| Typ FET | 2 N-Channel (Dual) |
| FET-Merkmal | Logic Level Gate |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 4.9A |

SI7212DN-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7212DN-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7212DN-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7212DN-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI7212DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8</p> |  <p>SI7212-B-00-IVR Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR PWM</p> |  <p>SI7212DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8</p> |  <p>SI7213-B-00-IVR Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR SENT</p> |
|  <p>SI7212DN-T1-GW3 VISHAY SI7212DN-T1-GW3 VISHAY</p> |  <p>SI7212DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8</p> |  <p>SI7212DN SI SI SI7212DN SI</p> |  <p>SI7211-B-00-IVR Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR ANALOG</p> |

SI7212DN-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|
| Schlüsselwort | SI7212DN-T1-E3 | SI7212DN-T1-E3 | SI7212DN-T1-E3 | SI7212DN-T1-E3 |
| SI7212DN-T1-E3 / Siliconix | SI7212DN-T1-E3 Datenblatt | SI7212DN-T1-E3-Datenblätter | SI7212DN-T1-E3 PDF | Vishay / Siliconix SI7212DN-T1-E3 |
| SI7212DN-T1-E3 Electronic | SI7212DN-T1-E3-Komponenten | SI7212DN-T1-E3-Verteiler | SI7212DN-T1-E3-Bild | SI7212DN-T1-E3-Teil |
| SI7212DN-T1-E3 Preis | SI7212DN-T1-E3 Hersteller | SI7212DN-T1-E3 Bild | SI7212DN-T1-E3 Aktie | SI7212DN-T1-E3 Inventar |
| SI7212DN-T1-E3 Neu | SI7212DN-T1-E3 Original | SI7212DN-T1-E3 garantiert | SI7212DN-T1-E3 RFQ | SI7212DN-T1-E3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited